

XIX Уральская международная зимняя школа по физике полупроводников

Ответственный за выпуск В.И. Окулов

Содержание

| | |
|--|-----|
| <i>Вступление</i> | 3 |
| <i>Гантмахер В.Ф.</i> Отсутствие перехода Андерсона в высокорезистивных сплавах с большой электронной плотностью | 5 |
| <i>Девятков Э.В.</i> Электронные интерферометры в режиме квантового эффекта Холла | 11 |
| <i>Демиховский В.Я., Тележников А.В., Фролова Е.В., Кравец Н.А.</i> Мезоскопические состояния в графене, находящемся в магнитном поле: коллапс и возрождение в Финовых пакетах | 26 |
| <i>Kagalovsky V.</i> Levitation of delocalized states at weak magnetic field: critical exponents and phase diagram | 37 |
| <i>Rozhansky I.V., Averkiev N.S., and Lähderanta E.</i> Configuration interaction in delta-doped heterostructures | 40 |
| <i>Вальков В.В., Аксенов С.В., Уланов Е.А.</i> Эффект Фано при туннелировании спин-поляризованного электрона через одиночную магнитную примесь | 48 |
| <i>Лингит И.И.</i> О возбуждении спинового тока звуковой волной | 53 |
| <i>Арапов Ю.Г., Гудина С.В., Неверов В.Н., Подгорных С.М., Якушин М.В.</i> Температурная зависимость квантового времени жизни в структурах <i>n</i> -InGaAs/GaAs с двойными сильно связанными квантовыми ямами | 58 |
| <i>Арапов Ю.Г., Гудина С.В., Неверов В.Н., Повокшинов С.Г., Клетикова А.С., Харус Г.И., Шелушинина И.Г., Якушин М.В.</i> Температурная зависимость ширины полосы делокализованных состояний в наноструктурах <i>n</i> -InGaAs/GaAs в режиме квантового эффекта Холла | 66 |
| <i>Кутьбачинский В.А., Лукин Р.А., Качан И.И., Великодный Ю.А., Тарасов В.П., Булычев Б.М.</i> Сверхпроводящие свойства новых гетерофуллеридов | 76 |
| <i>Лашкарев Г.В., Радченко М.В., Бугаева М.Э., Кнофф В., Стори Т., Стельмах Я.А., Крушинская Л.А., Дмитриев А.И., Лазоренко В.И., Сичковский В.И.</i> Ферромагнитные наноконпозиты как спинтронные материалы с управляемой магнитной структурой | 86 |
| <i>Скитешров Е.П., Голованов А.Н., Слышко Е.И., Слышко В.Е.</i> Электронная структура сплавов на основе теллурида свинца, легированных ванадием | 98 |
| <i>Лопчаков А.Т., Марченков В.В., Окулов В.И., Окулова К.А.</i> Псевдощелевое состояние и сильное рассеяние носителей тока на локальных спиновых моментах как механизмы появления полупроводниковых свойств почти стехиометрических сплавов железо–ванадий–алюминий | 109 |
| <i>Соколов В.И., Груздев Н.Б., Пустоваров В.А., Чурманов В.Н.</i> Проявление переходов с переносом заряда в спектрах фотолюминесценции оксидных материалов $Zn_{1-x}Me_xO$ (Me — Mn, Ni, Co) | 116 |